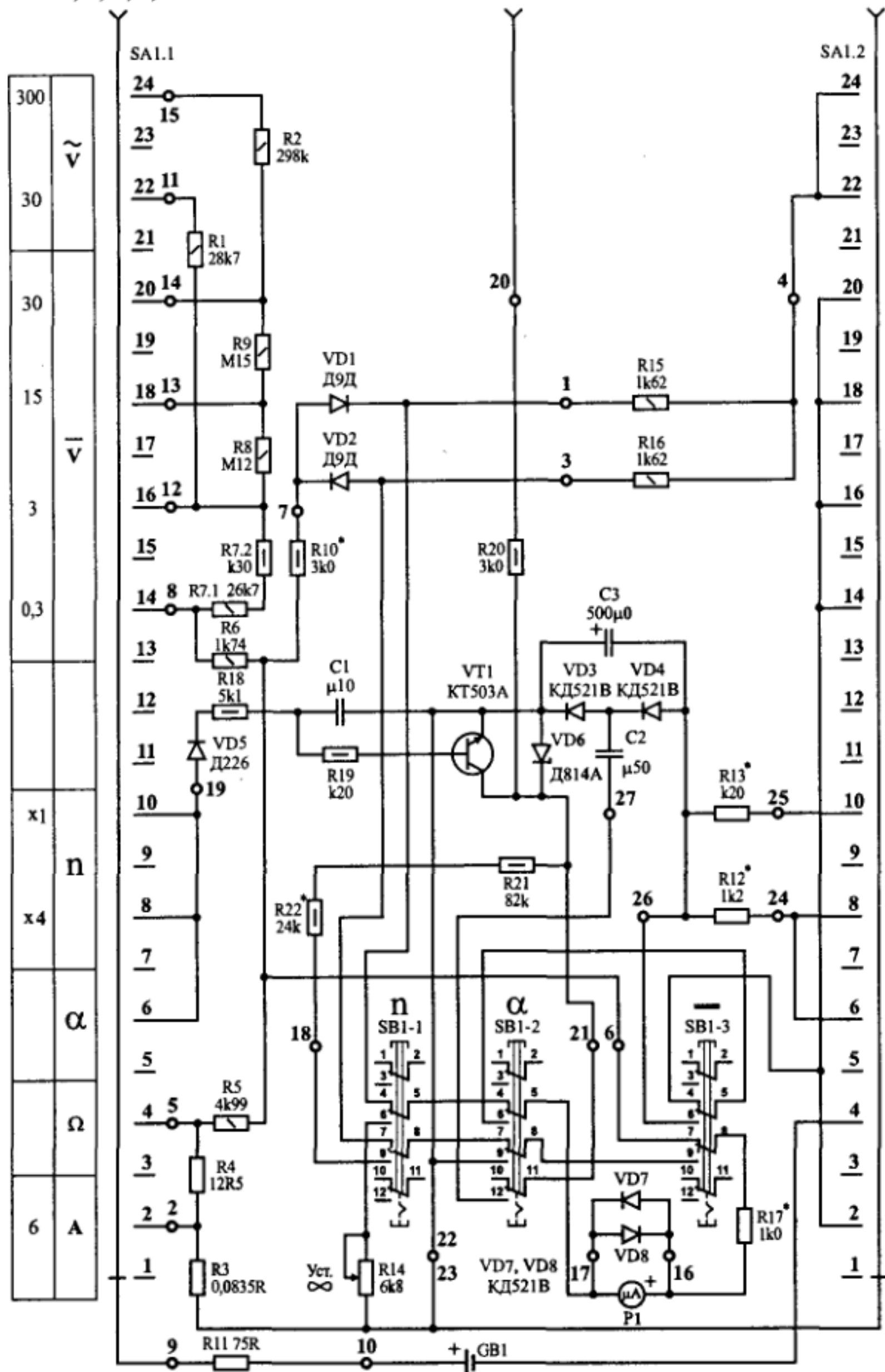


V, A, Ω, n, α

+12V

\*



Позиционное обозначение	Наименование элемента и тип	Кол-во	Примечание
<b>Резистор</b>			
R1	C2-29B-0,25-28,7 кОм ± 0,5 % -1,0-B	1	
R2	C2-29B-0,25-298 кОм ± 0,5 % -1,0-B	1	
R3	Шунт 0,0835 ± 0,0004 Ом	1	
R4	12,5 ± 0,05 Ом ПЭМС П - 0,25 мм	1	
R5	C2-29B-0,25-4,99 кОм ± 0,25 % -1,0-B	1	
R6	C2-29B-0,25-1,74 кОм ± 0,5% -1,0-B	1	
R7	C2-29B-0,25-26,7 кОм ± 0,5% -1,0-B	1	послед-но
	МЛТ-0,5-300 Ом ± 5 %	1	27 ± 0,08 кОм
R8	C2-29B-0,25-120 кОм ± 0,5 % -1,0-B	1	
R9	C2-29B-0.25-150 кОм ± 0,5 % -1,0-B	1	
R10*	МЛТ-0,5-2,4-3,9 кОм ± 5 %	1	подгоночный
R11	75 ± 0,35 Ом ПЭМС П - 0,15 мм	1	
R12*	до 1,6 кОм ПЭМС П - 0,08 мм	1	подгоночный
R13*	до 300 Ом ПЭМС П - 0,1 мм	1	подгоночный
R14	СПЗ-9а-1-6,8 кОм ± 20 % - 25	1	
R15, R16	C2-29B-0,25-1,62 кОм ± 1 % -1,0-B	2	
R17*	до 1,07 кОм ПЭМС П - 0,08 мм	1	подгоночный
R18	МЛТ-0,5-5,1 кОм ± 10 %	1	
R19	МЛТ-0,5-200 Ом ± 10 %	1	
R20	МЛТ-0,5-3,0 кОм ± 10 %	1	
R21	МЛТ-0,5-82 кОм ± 10 %	1	
R22*	МЛТ-0,5-20 кОм ± 10 %	1	подгоночный
<b>Конденсатор</b>			
C1	МБМ-160В 0,1 мкФ ± 10 % -В	1	
C2	МБМ-160В-0.5 мкФ ± 10 % -В	1	
C3	К50-6-Н-10В-500 мкФ - БИ	1	
<b>Транзистор</b>			
VT1	КТ503А	1	
<b>Диод</b>			
VD1, VD2	Д9Д	2	
VD3, VD4, VD7, VD8	КД521В	4	
VD6	Д814А	1	
VD5	Д226Б	1	